

Сведения о ведущей организации
 по диссертационной работе **Борисова Евгения Вадимовича**
 на тему **«Оптические свойства легированных эпитаксиальных слоев**
нитрида галлия и выращенных методом магнетронного распыления
оксидов цинка и меди»
 представленной на соискание ученой степени кандидата физико-
 математических наук
 по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния

Полное наименование организации в соответствии с Уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом	ИАП РАН
Почтовый индекс, адрес организации	190103, ИАП РАН, Рижский пр., 26, Санкт-Петербург,
Веб-сайт	iairas.ru
Телефон	(812) 363-0719
Адрес электронной почты	iap@ianin.spb.su
Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1. Р.Р.Резник, К.П.Котляр, И.В.Илькив, И.П.Сошников, С.А.Кукушкин, А.В.Осипов, Е.В.Никитина, Г.Э.Цырлин. «Рост и оптические свойства нитевидных нанокристаллов GaN, выращенных на гибридной подложке SiC/Si(111) методом молекулярно-пучковой эпитаксии», ФТТ, 2016, том 58, выпуск 10, с. 1886-1889</p> <p>2. А.М. Можаров, Д.А. Кудряшов, А.Д. Большаков, Г.Э. Цырлин, А.С. Гудовских, И.С. Мухин «Численное моделирование характеристик солнечных элементов на основе GaPNAs/Si гетероструктур и GaN нитевидных нанокристаллов», ФТП, 2016, том 50, выпуск 5, с.1543-1547</p> <p>3. Vladimir Neplokh, Ahmed Ali, Francois H. Julien, Martin Foldyna, Ivan Mukhin, George Cirlin, Jean-Christophe Harmand, NoelleGogneau, Maria Tchernycheva. "Electron beam induced current microscopy investigation of GaN nanowire arrays grown on Si substrates", Materials Science in Semiconductor Processing, 2016, v. 55, p. 72–78</p> <p>4. Alexei Bouravleuv, George Cirlin, Victor Sapega,</p>

Peter Werner, Alexander Savin, Harri Lipsanen.
Ferromagnetic (Ga,Mn)As nanowires grown by Mn-
assisted molecular beam epitaxy. // J. Appl. Phys.
113, 144303 (2013)

5. Хабибуллин Р.А., Н.В.Щаврук, А.Ю.Павлов,
Д.С.Пономарев, К.Н.Томош, Р.Р.Галиев, П.П
Мальцев., А.Е.Жуков, Г.Э.Цырлин, Ф.И.Зубов,
Ж.И. Алфёров. «Изготовление терагерцового
квантово-каскадного лазера с двойным
металлическим волноводом на основе
многослойных гетероструктур GaAs/AlGaAs»,
ФТП, 2016, том 50, выпуск 10, с. 1395 – 1400

6. В.Н. Трухин, А.Д. Буравлев, И.А. Мустафин,
Г.Э. Цырлин, Д.И. Курицын, В.В. Румянцев, С.В.
Морозов, J.P. Kakko, T. Huhtio, H. Lipsanen.
«Резонансный характер генерации терагерцового
излучения в полупроводниковых нитевидных
нанокристаллах», ФТП, 2016, том 50, выпуск 12,
с.1587-1591

Верно

Директор ИАП РАН

В

д.т.н. проф. Курочкин В.Е.

«*26*» *февраля* 2018 г.

